

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 25 年 9 月 26 日 (2013.9.26)

【公開番号】特開 2013-140716 (P2013-140716A)

【公開日】平成 25 年 7 月 18 日 (2013.7.18)

【年通号数】公開・登録公報 2013-038

【出願番号】特願 2012-399 (P2012-399)

【国際特許分類】

H 0 1 B 7/08 (2006.01)

【F I】

H 0 1 B 7/08

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 7 月 31 日 (2013.7.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 5

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 6】

絶縁フィルムと介在層を合わせた絶縁フィルムの実効比誘電率を ϵ_{eff} 、絶縁フィルムの比誘電率を ϵ_1 、介在層の比誘電率を ϵ_2 とすると、 ϵ_{eff} は ϵ_1 と ϵ_2 との加重平均である。図 2 などの断面で絶縁フィルムの断面積を S_1 、介在層の断面積を S_2 とすると、 $\epsilon_{eff} = (\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2) / (S_1 + S_2)$ である。

平角導体からシールド層までの非金属層の実効比誘電率は図 5 の場合では絶縁フィルム 3 と介在層 7 とを合わせた比誘電率となる。絶縁フィルム 3 の比誘電率を介在層 7 の比誘電率よりも小さくすることにより、両者を合わせた比誘電率（言い換えると平角導体からシールド層までの非金属層の実効比誘電率）は絶縁フィルム 3 の比誘電率よりも大きくなる。